

RoHS対応品

■特長

- 小型低背セラミックパッケージ
2.5(L)×2.0(W)×0.7(H)mm(Typ.)
- シーム封止による高信頼性
- CMOS出力
- 電源電圧 1.8/ 2.5/ 3.3V兼用仕様
幅広い電源電圧範囲に対応 1.6~3.63V
- 低消費電流タイプ
- AEC-Q100/ 200に準拠

■周波数許容偏差(Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備 考
F ±100	-40 ~ +85	対応可能周波数についてはお問い合わせください
G ± 50	-40 ~ +105	わせください
6 ± 50	-40 ~ +125	標準仕様

■品名表示方法

KC2520M 25.000 C 1 X E 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②出力周波数
- ③出力形態(CMOS)
- ④電源電圧(1.8V、2.5V、3.3V 兼用仕様)
- ⑤周波数許容偏差(左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能(45/ 55%、スタンバイ)
- ⑦客先個別仕様(カタログ仕様は「00」になります)

包装形態(テーピング 2000個/ リール)

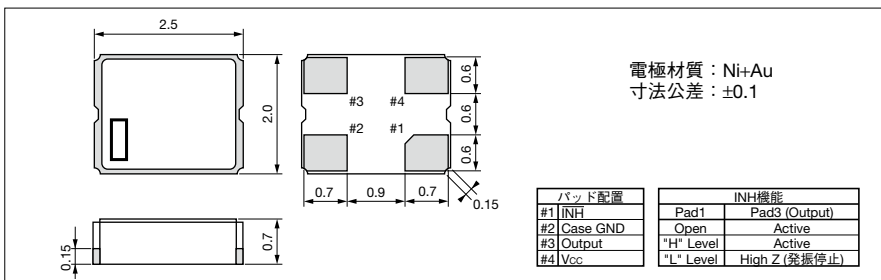
■規格

項 目	記 号	条 件	規 格		単 位
			Min.	Max.	
出力周波数範囲*	fo		1.5	60	MHz
周波数許容偏差	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内の温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化(1 year @25°C)、振動・衝撃を含む Op. Temp. : -40 ~ +125°C	-100	+100	×10 ⁻⁶
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C
動作温度範囲	T _{use}		-40	+125	°C
最大定格電圧	—	1.5≤fo≤60MHz	-0.6	+6.5	V
電源電圧	V _{cc}		+1.6	+3.63	V
消費電流 (最大負荷時/ 1.6<V _{cc} ≤2.0V)	I _{cc}	1.5≤fo≤24MHz	—	2.5	mA
消費電流 (最大負荷時/ 2.0<V _{cc} ≤2.8V)		24<fo≤40MHz	—	3.0	
消費電流 (最大負荷時/ 2.8<V _{cc} ≤3.63V)		40<fo≤60MHz	—	4.5	
		1.5≤fo≤24MHz	—	3.0	
スタンバイ時電流	24<fo≤40MHz	—	4.0		
	40<fo≤60MHz	—	5.0		
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{cc}	45	55	%
立上り/ 立下り時間 (10%V _{cc} ~90%V _{cc} 最大負荷時)	tr/ tf	1.6≤V _{cc} ≤2.0V 2.0<V _{cc} ≤2.8V 2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	6.5 5.5 4.5	ns
Lレベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} = 4mA	—	10% V _{cc}	V
Hレベル出力電圧	V _{OH}	I _{OH} = -4mA	90% V _{cc}	—	V
出力負荷条件(CMOS)	L _{CMOS}	CMOS Output	—	15	pF
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{cc}	V
Hレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{cc}	—	V
ディセーブル時間	t _{dis}		—	100	ns
イネーブル時間	t _{ena}		—	5	ms
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	Wavecrest SIA-3000にて測定	—	8	ps
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}		—	80	ps

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。 * レンジ外の周波数については、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

